

2SD892, 2SD892A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形ダーリントン/Si NPN

Epitaxial Planar Darlington

低周波増幅用/AF Amplifier

■ 特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高く設計されているので、モータドライブ、プリンタ用ハンマドライブなどに適している： $h_{FE} = 2000 \sim 20000$ /High h_{FE} design, suitable for motor driver and hammer driver: $h_{FE} = 2000 \sim 20000$.
- ドライバにはシャント抵抗を省いている。/Driver having no shunt resistor.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

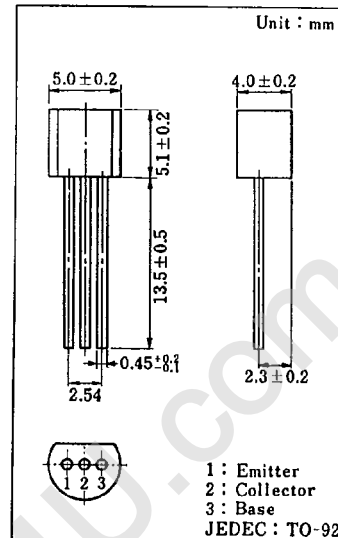
Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
		60	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	25	V
		50	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	0.75	A
コレクタ電流	I_C	0.5	A
コレクタ損失	P_C	400*	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{sig}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

*ポッティングタイプは $P_C = 250 \text{ mW}$ /Potting type: $P_C = 250 \text{ mW}$ ■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

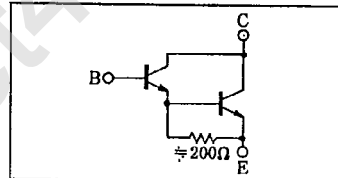
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 25 \text{ V}, I_E = 0$			100	nA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 4 \text{ V}, I_C = 0$			100	nA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 100 \mu\text{A}, I_E = 0$	30			V
			60			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 1 \text{ mA}, I_B = 0$	25			V
			50			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 100 \mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}^{*1}	$V_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 500 \text{ mA}^{*2}$	2000		20000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 0.5 \text{ mA}^{*2}$			2.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 0.5 \text{ mA}^{*2}$			3	V

*²パルス測定/Pulse Test*¹ h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

Class	P	Q	R
h_{FE}	2000~5000	4000~10000	8000~20000



内部接続図/Connection Diagram



トランジスタ

2SD892, 2SD892A

T-29-27

